

Внутренняя шина

AD: A15
D0-D7
 $\overline{WR}$
 $\overline{RD}$
 $\overline{IORQ} / \overline{T0}$
 $\overline{MREQ} / \overline{MR}$
 $\overline{ETS}$
CS10

DD1 и DD2 монтировать "таксовыми" на отдельные выводы БИС ОЗУ.
DD3 и DD4 монтировать на выходы микросхем.

DD1, DD2 - HMM62256 LP10
DD3 - K561MA9A
DD4 - K561AP13

Общий объем ОЗУ-накопителей составляет 80 Кбайт. Из них:
8к - память загрузчика RAM
8к - загрузчик ПЗУ DISK
32к - универсальный модуль DRAM
32к - накопитель типа SBB-RAMV
Взяты дан. 1 и Дан. 2

Проверено по макету
22.03.98
Б.А. Крутицкий

Шина LOKBAS допускает прямое подключение БИС 5800B79 с программным адресом отступа клавиатуры, авто калибровка X5+X4 в любой корректной реакции.
Все ЦАП имеют стандартизовано разводу питания. Каждый корпус смонтирован код. KM55 Q1-Q15rit

DD1
RAM 32x8k
8000H ÷ FFFFH
DRAM
A0-A14
D0-D7
 $\overline{WR}$
 $\overline{CE0}$
CS

DD2
RAM 32x8k
8000H ÷ FFFFH
RAUV
A0-A14
D0-D7
 $\overline{WR}$
 $\overline{CE0}$
CS

DD3.1
DD3.2
DD4.1
DD4.2

+5V
4.7к
+5V
4.7к
+5V
4.7к
+5V
4.7к

A15
A15
A15
A15

ETS
TORQ
TORQ
TORQ

8000H ÷ FFFFH
в режиме IORQ

CS10

DD4.2

8000H ÷ FFFFH

CS10

Общий объём ОЗУ - накопитель
составляет 80 Кбайт. Из них
8 к - память загрузчика RAM
8 к - загрузчик ОЗУ DISK
32 к - универсальный модуль DRAM
32 к - накопитель типа BB - RAM V
Взамен Don. 1 и Don. 2

Проведено по плану
22.03.98

Школа LOKBAS допускает прямое подключение БИС 580BB29 с преобразованием клавиатуры, либо комбинацию $X5 + X4$ с реакцией на все ЦВ имеют стандартную разводку питания. База данных корпусов и